

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2012

№ 6

Год издания 36-й

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

*Д.т.н. И. М. Вакув (г. Львов)
Д.т.н. В. П. Годоватов (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
Н. В. Кошчи (г. Киев)
Д.ф. м.н. В. Ф. Мачуши (г. Киев)
Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)
Е. А. Тихонова (г. Одесса)*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Д.т.н. С. Г. Антошук (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Анушов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
К.т.н. Э. П. Глушеченко,
зам. г.г. редактора (г. Киев)
Д.т.н. В. В. Дашков (г. Донецк)
К.т.н. П. П. Ермашич,
зам. г.г. редактора (г. Одесса)
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь (г. Одесса)
Д.ф. м.н. Д. В. Корбушак (г. Киев)
Д.т.н. С. Ю. Лузи (г. С.-Петербург)
Д.т.н. В. Н. Малахов (г. Одесса)
К.т.н. Н. А. Милосева (г. Киев)
Д.т.н. П. П. Певлюдов (г. Харьков)
Д.т.н. Ю. Е. Николаешко (г. Киев)
К.ф. ч.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюшин (г. Черновцы)
Д.ф. м.н. М. П. Самойлович (г. Москва)
Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)
Д.т.н. Я. Степанович (г. Белград)
Д.т.н. З. Стевич (г. Белград)
Д.х.н. В. П. Томашик (г. Киев)
Д.т.н. В. М. Шокарь (г. Харьков)
Д.ф. м.н. О. П. Шпотиюк (г. Львов)*

УЧРЕДИТЕЛИ

МНН Украины
Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарева
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство «Политехперіодика»

Одобрено к печати Ученым советом
ОИИУ
(Протокол № 3 от 25.12.2012 г.)

Техническая политика

Система единого генератора. *Басюк О. П.* 3

Электронные средства: исследования, разработки

Твердотельный импульсный микроволновой мост для спектрометров электронного синхротрона 8-мм диапазона длины волн. *Калабухова Е. П., Олейник В. В., Савченко Д. В., Ситников А. А., Цвир А. В., Пещенко М. Г.* 5

СВЧ-техника

Особенности реализации микрополосковых фильтров с кольцевыми резонаторами бегущей волны. *Глушеченко Э. П.* 11

Пределы управляемости диэлектрической неоднородности, расположенной между металлическими плоскостями. *Прокопенко Ю. В.* 16

Методы формирования алгоритмов для расчета перестраиваемых коаксиальных полосковых фильтров СВЧ. *Нарфилов А. А.* 21

Сенсоэлектроника

Высокотемпературные датчики давления с тензорезисторами на основе шптевидных кристаллов кремния. *Дружшин А. А., Кутраков А. П., Марьямова П. П.* 25

Функциональная микро- и наноэлектроника

Характеристики фотодиодов со структурой «собственный оксид InSe», облученных высокоэнергетическими электронами. *Сидор О. Н., Сидор О. А., Ковалюк З. Д., Дубинко В. П.* 29

Технологические процессы и оборудование

Получение тонких пленок Si₃N₄ при пониженном давлении на пластинах диаметром до 200 мм. *Паливайко О. Ю., Турцевич А. С.* 34

Материалы электроники

Гетеропереходы, сформированные окантовкой с тонких кристаллов GaSe и InSe в парах цинка. *Кудринский З. Р., Ковалюк З. Д.* 40

Стимулируемая водородом миграция атомов металлов в структурах «металл – полупроводник». *Машушин В. М., Жавжаров Е. Л.* 44

Метрология. Стандартизация

Визуальные и оптико-электронные автоколлиматоры. *Фесенко А. В., Боровицкий В. П.* 49

Список рецензентов номера

3-я стр. обложки

Новые книги

33

Конференции

48; 3-я стр. обложки

Портфель редакции

24